

Technische Information / Technical Information

eupec

Netz-Thyristor-Modul
Phase Control Thyristor Module

TZ 150 N 18...26

N


Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltages | $T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{ max}}$ | $V_{\text{DRM}}, V_{\text{RRM}}$ | 1800, 2000 2200, 2400 2600 | V V V |
| Vorwärts-Stoßspitzensperrspannung non-repetitive peak forward off-state voltage | $T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{ max}}$ | V_{DSM} | 1800, 2000 2200, 2400 2600 | V V V |
| Rückwärts-Stoßspitzensperrspannung non-repetitive peak reverse voltage | $T_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{ max}}$ | V_{RSM} | 1900, 2100 2300, 2500 2700 | V V V |
| Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert RMS on-state current | | I_{TRMSM} | 350 | A |
| Dauergrenzstrom average on-state current | $T_{\text{C}} = 85^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{C}} = 54^{\circ}\text{C}$ | I_{TAVM} | 150 223 | A A |
| Stoßstrom-Grenzwert surge current | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_p = 10\text{ms}$ | I_{TSM} | 4500 4000 | A A |
| Grenzlastintegral I^2t -value | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_p = 10\text{ms}$ | I^2t | 101000 80000 | A ² s A ² s |
| Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current | DIN IEC 747-6 $f = 50\text{Hz}, i_{\text{GM}} = 1\text{A}, di_{\text{G}}/dt = 1\text{A}/\mu\text{s}$ | $(di_{\text{T}}/dt)_{\text{cr}}$ | 60 | A/ μs |
| Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage | $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_{\text{D}} = 0,67 V_{\text{DRM}}$ 6. Kennbuchstabe / 6th letter C 6. Kennbuchstabe / 6th letter F | $(dv_{\text{D}}/dt)_{\text{cr}}$ | 500 1000 | V/ μs V/ μs |

Charakteristische Werte / Characteristic values

| | | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------|----------|
| Durchlaßspannung on-state voltage | $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, i_{\text{T}} = 600\text{A}$ | V_{T} | max. 2,6 | V |
| Schleusenspannung threshold voltage | $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$ | $V_{(\text{TO})}$ | 1,2 | V |
| Ersatzwiderstand slope resistance | $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$ | r_{T} | 2,3 | mW |
| Zündstrom gate trigger current | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 6\text{V}$ | I_{GT} | max. 200 | mA |
| Zündspannung gate trigger voltage | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 6\text{V}$ | V_{GT} | max. 2,0 | V |
| Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current | $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_{\text{D}} = 6\text{V}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$ | I_{GD} | max. 10 max. 5 | mA mA |
| Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage | $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$ | V_{GD} | max. 0,2 | V |
| Haltestrom holding current | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 6\text{V}, R_{\text{A}} = 5\text{W}$ | I_{H} | max. 300 | mA |
| Einraststrom latching current | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 6\text{V}, R_{\text{GK}} \approx 10\text{W}$ $i_{\text{GM}} = 1\text{A}, di_{\text{G}}/dt = 1\text{A}/\mu\text{s}, t_{\text{G}} = 20\mu\text{s}$ | I_{L} | max. 1200 | mA |
| Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse currents | $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$ $V_{\text{D}} = V_{\text{DRM}}, V_{\text{R}} = V_{\text{RRM}}$ | $i_{\text{D}}, i_{\text{R}}$ | max. 50 | mA |



Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

| | | | | |
|--|---|------------|------------|---------------|
| Zündverzug gate controlled delay time | DIN IEC 747-6 $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $i_{GM} = 1\text{A}$, $di_G/dt = 1\text{A}/\mu\text{s}$ | t_{gd} | max. 4,0 | μs |
| Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time | $T_{vj} = T_{vj\max}$, $i_{TM} = 150\text{A}$ $V_{RM} = 100\text{V}$, $V_{DM} = 0,67 V_{DRM}$ $dv_D/dt = 20\text{V}/\mu\text{s}$, $-di_T/dt = 10\text{A}/\mu\text{s}$ 5. Kennbuchstabe / 5th letter O | t_q | typ. 300 | μs |
| Isolations-Prüfspannung insulation test voltage | RMS, $f = 50\text{Hz}$, $t = 1\text{min}$ RMS, $f = 50\text{Hz}$, $t = 1\text{sec}$ | V_{ISOL} | 3,0 3,6 | kV kV |

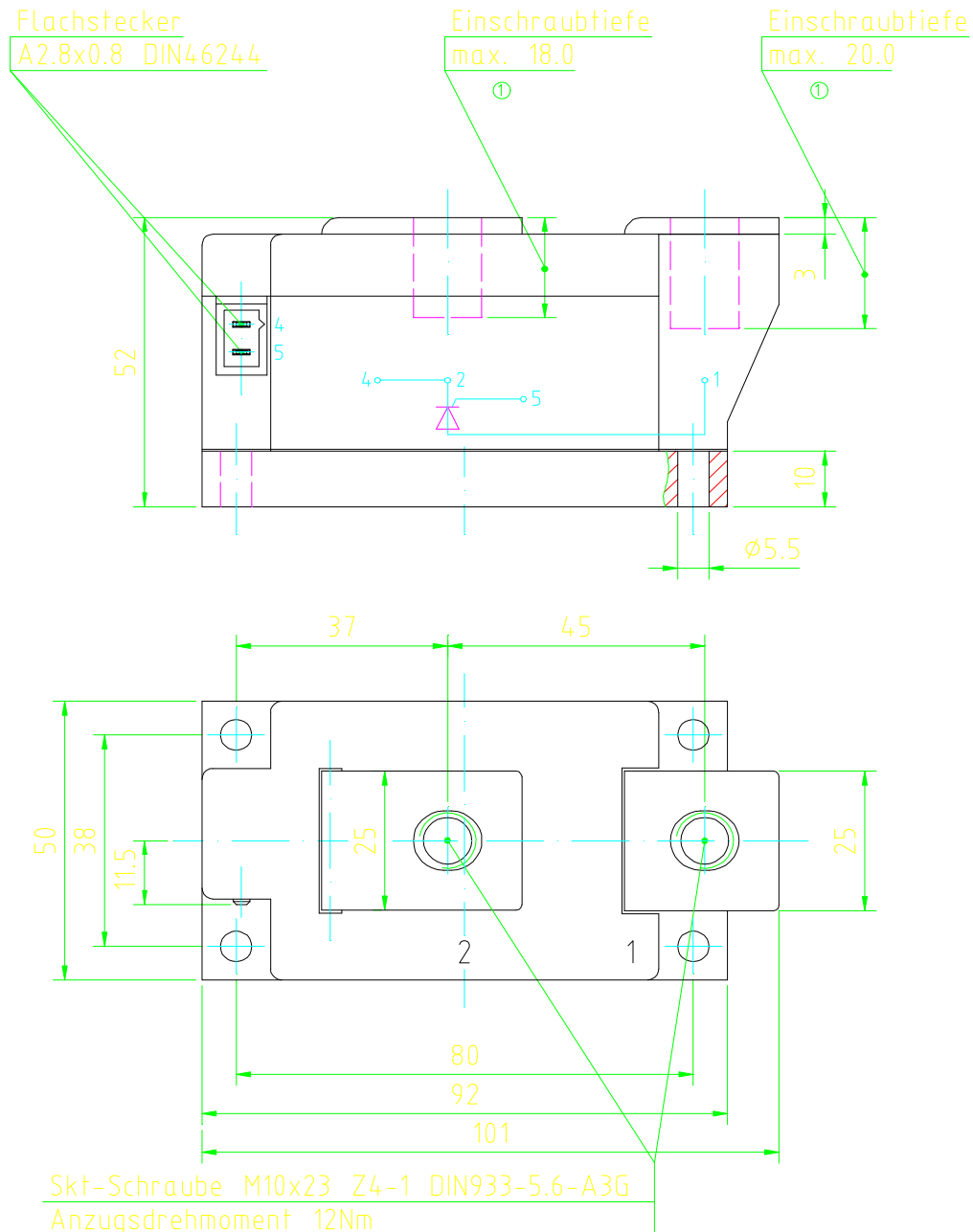
Thermische Eigenschaften / Thermal properties

| | | | | |
|---|--|------------------|--------------------------|--|
| Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case | pro Modul / per module, $\Theta = 180^{\circ}\sin$ pro Modul / per module, DC | R_{thJC} | max. 0,130 max. 0,124 | $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ |
| Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink | pro Modul / per module | R_{thCK} | max. 0,040 | $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ |
| Höchstzulässige Sperrschichttemperatur max. junction temperature | | $T_{vj\max}$ | 125 | $^{\circ}\text{C}$ |
| Betriebstemperatur operating temperature | | $T_{c\text{op}}$ | - 40...+125 | $^{\circ}\text{C}$ |
| Lagertemperatur storage temperature | | T_{sta} | - 40...+130 | $^{\circ}\text{C}$ |

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

| | | | | |
|---|---------------------------------------|----|-------------------|----------------|
| Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix | | | Seite 3 page 3 | |
| Si-Elemente mit Druckkontakt Si-pellets with pressure contact | | | | |
| Innere Isolation internal insulation | | | AIN | |
| Anzugsdrehmoment für mechanische Befestigung mounting torque | Toleranz / tolerance $\pm 15\%$ | M1 | 5 | Nm |
| Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse terminal connection torque | Toleranz / tolerance $+5\%$ / -10% | M2 | 12 | Nm |
| Gewicht weight | | G | typ. 900 | g |
| Kriechstrecke creepage distance | | | 15 | mm |
| Schwingfestigkeit vibration resistance | $f = 50\text{Hz}$ | | 50 | m/s^2 |

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen. / This technical Information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.



Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} für DCAnalytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} for DC

| Pos. n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|
| $R_{thn} [^{\circ}\text{C} / \text{W}]$ | 0,0031 | 0,0097 | 0,0257 | 0,0429 | 0,0426 | | |
| $\tau_n [\text{s}]$ | 0,0009 | 0,0080 | 0,1100 | 0,6100 | 3,0600 | | |

Analytische Funktion:
$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$$